

Prüfdaten
von Halbleiterdioden
aus aller Welt

Test operation of germanium diodes and silicon diodes.

Vérification des diodes au germanium et diodes
au silicium.

Halbleitertypen

Crystal diodes

Fabrikat	Type	Prüfdaten / Test operation / Verification	
		In Durchlaßrichtung Direction of postage bei +25°C U _D	In Sperrrichtg. Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C I _{sp}
Valvo	OA 5	+0,55 V	max 6 µA
"	OA 7	+0,42 V	max 0,6 µA
AEG	OA 20/500	+0,32 V	max 1,4 µA
Tekade	OA 21	+0,5 V	max 25 µA
AEG	OA 30/30	+0,5 V	max 75 µA
Valvo	OA 31	+1,0 V	max 7 µA
AEG	OA 40/100	+0,3 V	max 35 µA
Tekade	OA 41	+1,0 V	max 10 µA
Valvo	OA 47	+1,0 V	max 4 µA
AEG	OA 50	+0,5 V	max 85 µA
	OA 50/50	+0,5 V	max 15 µA
Valvo	OA 51	+1,0 V	max 10 µA
"	OA 52	+1,0 V	max 32 µA
"	OA 53	+1,0 V	max 30 µA
"	OA 55	+1,0 V	max 25 µA
"	OA 56	+1,0 V	max 48 µA
AEG	OA 60	+1,0 V	max 35 µA
Valvo	OA 60/5	+1,0 V	max 5 µA
"	OA 61	+1,0 V	max 10 µA
"	OA 70	+1,2 V	max 30 µA
"	OA 71	+1,0 V	max 2 µA
"	OA 72	+1,0 V	max 1,5 µA
"	OA 73	+1,0 V	max 30 µA
"	OA 74	+1,0 V	max 12 µA
"	OA 79	+1,2 V	max 5 µA
AEG	OA 80/5	+1,0 V	max 32 µA
"	OA 80/10	+1,0 V	max 10 µA
Valvo	OA 81	+1,2 V	max 0,5 µA
"	OA 85	+1,0 V	max 5 µA

Halbleitertypen

Crystal diodes

Fabrikat	Type	Prüfdaten / Test operation / Verification	
		In Durchlaßrichtung Direction of postage bei +25°C U _D	In Sperrrichtg. Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C I _{sp}
Valvo	OA 86	+1,0 V	max 6 µA
"	OA 87	+1,12 V	max 7 µA
"	OA 90	+1,0 V	max 50 µA
"	OA 91	+1,0 V	max 8 µA
"	OA 95	+1,0 V	max 5 µA
AEG	OA 100/30	+0,5 V	max 5 µA
Telefunken	OA 126	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/4	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/5	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/6	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/7	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/8	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/9	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/10	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/11	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/12	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/14	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 126/18	+0,85 V	max 0,1 µA
"	OA 127	+1,0 V	max 0,1 µA
"	OA 128	+1,0 V	max 0,1 µA
"	OA 129	+1,0 V	max 0,1 µA
"	OA 130	+1,0 V	max 0,1 µA
"	OA 131	+1,0 V	max 0,1 µA
"	OA 132	+1,0 V	max 0,1 µA
"	OA 150	+1,0 V	max 10 µA
AEG	OA 150/5	+1,0 V	max 5 µA
"	OA 150/10	+1,0 V	max 5 µA
Telefunken	OA 154 Q	+1,0 V	max 15 µA
"	OA 159	+1,0 V	max 20 µA

Halbleiterdioden

Crystal diodes

Prüfdaten / Test operation / Verification

In Durchschichtung
Direction of passage
Direction de passage
bei +25°CIn Sperrrichtung
Max Peak inverse
Max Peak inverse
bei +25°C

Fabrikat

Type

U_DI_DI_{Sp}

Amerika	1N 34	+1,0 V	min. 5 mA	max 20 µA
"	1N 34 A	+1,0 V	min. 5 mA	max 10 µA
"	1N 34 D	+1,0 V	min. 5 mA	max 25 µA
"	1N 35	+1,0 V	min. 7,5 mA	max 7 µA
"	1N 38	+1,0 V	min. 3 mA	max 7 µA
"	1N 38 A	+1,0 V	min. 4 mA	max 6 µA
"	1N 38 D	+1,0 V	min. 3 mA	max 20 µA
"	1N 39	+1,0 V	min. 1,5 mA	max 10 µA
"	1N 39 A	+1,0 V	min. 3 mA	max 20 µA
"	1N 39 D	+1,0 V	min. 1,5 mA	max 20 µA
"	1N 40	+1,5 V	min. 12 mA	max 20 µA
"	1N 42	+1,5 V	min. 12 mA	max 7 µA
"	1N 43	+1,0 V	min. 5 mA	max 50 µA
"	1N 43 D	+1,0 V	min. 3 mA	max 30 µA
"	1N 44	+1,0 V	min. 3 mA	max 40 µA
"	1N 44 D	+1,0 V	min. 3 mA	max 50 µA
"	1N 45	+1,0 V	min. 3 mA	max 25 µA
"	1N 45 D	+1,0 V	min. 3 mA	max 25 µA
"	1N 46	+1,0 V	min. 3 mA	max 70 µA
"	1N 46 D	+1,0 V	min. 4 mA	max 50 µA
"	1N 47	+1,0 V	min. 3 mA	max 5 µA
"	1N 48	+1,0 V	min. 4 mA	max 25 µA
"	1N 49	+1,0 V	min. 4 mA	max 10 µA
"	1N 50	+1,0 V	min. 4 mA	max 20 µA
"	1N 51	+1,0 V	min. 2,5 mA	max 60 µA
"	1N 51 D	+1,0 V	min. 2,5 mA	max 60 µA
"	1N 52	+1,0 V	min. 4 mA	max 15 µA
"	1N 52 D	+1,0 V	min. 4 mA	max 15 µA

Halbleiterdioden

Crystal diodes

Prüfdaten / Test operation / Verification

In Durchschichtung
Direction of passage
Direction de passage
bei +25°CIn Sperrrichtung
Max Peak inverse
Max Peak inverse
bei +25°C

Fabrikat

Type

U_DI_DI_{Sp}

Amerika	1N 54	+1,0 V	min. 5 mA	max 5 µA
"	1N 54 A	+1,0 V	min. 5 mA	max 5 µA
"	1N 54 D	+1,0 V	min. 5 mA	max 5 µA
"	1N 55	+1,0 V	min. 3 mA	max 20 µA
"	1N 55 A	+1,0 V	min. 4 mA	max 20 µA
"	1N 55 B	+1,0 V	min. 5 mA	max 20 µA
"	1N 56	+1,0 V	min. 15 mA	max 25 µA
"	1N 56 A	+1,0 V	min. 15 mA	max 25 µA
"	1N 56 D	+1,0 V	min. 15 mA	max 25 µA
"	1N 57	+1,0 V	min. 4 mA	max 30 µA
"	1N 57 A	+1,0 V	min. 4 mA	max 30 µA
"	1N 58	+1,0 V	min. 4 mA	max 30 µA
"	1N 58 A	+1,0 V	min. 4 mA	max 25 µA
"	1N 58 D	+1,0 V	min. 4 mA	max 30 µA
"	1N 59	+1,0 V	min. 3 mA	max 20 µA
"	1N 59 A	+1,0 V	min. 3 mA	max 20 µA
"	1N 60	+1,0 V	min. 5 mA	max 40 µA
"	1N 60 A	+1,0 V	min. 5 mA	max 40 µA
"	1N 60 D	+1,0 V	min. 5 mA	max 15 µA
"	1N 61	+1,0 V	min. 4 mA	max 10 µA
"	1N 63	+1,0 V	min. 4 mA	max 10 µA
"	1N 63 D	+1,0 V	min. 4 mA	max 10 µA
"	1N 64	+1,0 V	min. 0,1 mA	max 50 µA
"	1N 64 A	+1,0 V	min. 5 mA	max 40 µA
"	1N 64 D	+1,0 V	min. 0,1 mA	max 40 µA
"	1N 65	+1,0 V	min. 2,5 mA	max 15 µA
"	1N 65 D	+1,0 V	min. 2,5 mA	max 15 µA

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification		Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Sperrrichtung Max Peak Inverse Inverse de crête bei +25°C		Crystal diodes		In Sperrrichtung Max Peak Inverse Inverse de crête bei +25°C	
Fabrikat	Type	U _b	I _D	Fabrikat	Type	U _b	I _D
Amerika	1N66	+1,0 V	5 mA	Hughes	1N95	+1,0 V	10 mA
"	1N67	+1,0 V	4 mA	Dectron	1N95 D	+1,0 V	10 mA
"	1N67 A	+1,0 V	4 mA	Hughes	1N96	+1,0 V	20 mA
"	1N68	+1,0 V	3 mA	"	1N97	+1,0 V	10 mA
"	1N68 A	+1,0 V	3 mA	Transitron	1N97 A	+1,0 V	20 mA
"	1N69	+1,0 V	5 mA	Dectron	1N97 D	+1,0 V	10 mA
"	1N69 A	+1,0 V	5 mA	Hughes	1N98 A	+1,0 V	40 mA
"	1N69 D	+1,0 V	5 mA	Amerika	1N98 A	+1,0 V	40 mA
"	1N70	+1,0 V	3 mA	Hughes	1N99	+1,0 V	10 mA
"	1N70 A	+1,0 V	3 mA	Dectron	1N99 D	+1,0 V	10 mA
"	1N70 D	+1,0 V	3 mA	"	"	"	"
"	1N72	+0,5 V	0,8 mA	Hughes	1N100	+1,0 V	10 mA
"	1N72 D	+0,3 V	0,8 mA	Amerika	1N106	+1,0 V	20 mA
"	1N73	+1,0 V	1,3 mA	"	1N107	+1,0 V	150 mA
"	1N75	+1,0 V	2,5 mA	"	1N108	+1,0 V	50 mA
"	"	"	"	"	1N109	+1,0 V	8,5 mA
Amerika	1N81	+1,0 V	3 mA	"	1N111	+1,0 V	5 mA
Hughes	1N81 A	+1,0 V	3 mA	"	1N112	+1,0 V	5 mA
Amerika	1N86	+1,0 V	4 mA	"	1N113	+1,0 V	2,5 mA
Dectron	1N86 D	+1,0 V	4 mA	"	1N114	+1,0 V	2,5 mA
Amerika	1N87	+1,0 V	5 mA	"	1N115	+1,0 V	2,5 mA
Dectron	1N87 D	+1,0 V	5 mA	"	"	"	"
Amerika	1N88	+1,0 V	2,5 mA	Hughes	1N116	+1,0 V	5 mA
Hughes	1N89	+1,0 V	3,5 mA	Dectron	1N116 D	+1,0 V	5 mA
"	1N90	+1,0 V	5 mA	Hughes	1N117	+1,0 V	10 mA
"	"	"	"	"	1N118	+1,0 V	20 mA
Amerika	1N91	+0,2 V	200 mA	"	"	"	"
"	1N92	+0,3 V	180 mA	Amerika	1N119	+1,0 V	5 mA
"	1N93	+0,36 V	150 mA	"	1N120	+1,0 V	5 mA
"	1N94	+0,7 V	1,5 mA	"	1N124	+0,75 V	10 mA

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25°C	In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C Isp
Fabrikat	Type	U _D Id	I _{sp}
Hughes Dectron	1N126 1N126D	+1,0 V +1,0 V	min. 5 mA max 35 µA
Hughes	1N127	+1,0 V	min. 3 mA max 5 µA
"	1N128	+1,0 V	min. 3 mA max 6 µA
Amerika	1N133	+0,5 V	min. 3 mA max 90 µA
"	1N137	+1,0 V	min. 3 mA max 0,01 µA
"	1N137A	+1,0 V	min. 3 mA max 0,01 µA
Transistron Amerika	1N137B 1N138A 1N139	+1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 20 mA min. 5 mA min. 20 mA max 0,01 µA
"	1N140	+1,0 V	min. 40 mA max 30 µA
"	1N141	+1,0 V	min. 20 mA max 5 µA
"	1N142	+1,0 V	min. 5 mA max 10 µA
"	1N143	+1,0 V	min. 40 mA max 10 µA
"	1N147	+0,75 V	min. 10 mA max 60 µA
Hytron	1N148	+0,25 V	min. 0,28 mA max 60 µA
Amerika	1N151	+0,1 V	min. 200 mA max 60 µA
"	1N152	+0,1 V	min. 200 mA max 40 µA
"	1N153	+0,1 V	min. 200 mA max 20 µA
Hughes	1N191	+1,0 V	min. 5 mA max 25 µA
"	1N192	+1,0 V	min. 5 mA max 25 µA
Amerika	1N193	+1,0 V	min. 0,5 mA max 8 µA
"	1N194	+1,0 V	min. 0,8 mA max 10 µA
"	1N195	+1,0 V	min. 1 mA max 12 µA
"	1N196	+1,0 V	min. 0,5 mA max 5 µA
"	1N198	+1,0 V	min. 5 mA max 25 µA

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25°C	In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C Isp
Fabrikat	Type	U _D Id	I _{sp}
Amerika	1N200	+1,0 V	min. 50 mA max 0,1 µA
"	1N201	+1,0 V	min. 35 mA max 0,1 µA
"	1N202	+1,0 V	min. 30 mA max 0,1 µA
"	1N203	+1,0 V	min. 23 mA max 0,1 µA
"	1N204	+1,0 V	min. 17 mA max 0,1 µA
"	1N205	+1,0 V	min. 12 mA max 0,1 µA
"	1N206	+1,0 V	min. 9 mA max 0,1 µA
"	1N207	+1,0 V	min. 7 mA max 0,1 µA
"	1N208	+1,0 V	min. 5,5 mA max 0,1 µA
"	1N209	+1,0 V	min. 4,5 mA max 0,1 µA
"	1N210	+1,0 V	min. 3,5 mA max 0,1 µA
"	1N211	+1,0 V	min. 2,7 mA max 0,1 µA
"	1N212	+1,0 V	min. 2 mA max 0,1 µA
"	1N213	+1,0 V	min. 1,5 mA max 0,1 µA
"	1N214	+1,0 V	min. 1,2 mA max 0,1 µA
"	1N215	+1,0 V	min. 0,9 mA max 0,1 µA
"	1N216	+1,0 V	min. 0,7 mA max 0,1 µA
"	1N217	+1,0 V	min. 0,5 mA max 0,2 µA
"	1N218	+1,0 V	min. 0,4 mA max 0,1 µA
"	1N219	+1,0 V	min. 3 mA max 0,1 µA
"	1N220	+1,0 V	min. 2,2 mA max 0,1 µA
"	1N221	+1,0 V	min. 2 mA max 0,1 µA
"	1N222	+1,0 V	min. 1,5 mA max 0,1 µA
"	1N265	+1,0 V	min. 3,2 mA max 12 µA
"	1N266	+1,0 V	min. 4 mA max 10 µA
"	1N267	+1,0 V	min. 3,5 mA max 0,1 µA
"	1N268	+1,0 V	min. 6 mA max 14 µA

Halbleiterdioden Crystal diodes		Prüfdaten / Test operation / Verification	
		In Durchlafrichtung Direction of passage bei +25°C Up Id	In Sperrrichtg. Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C Isp
Fabrikat	Type		
Amerka	1N 270	+1,0 V min. 200 mA	max 20 μ A
"	1N 279	+1,0 V min. 100 mA	max 30 μ A
"	1N 283	+1,0 V min. 200 mA	max 10 μ A
Raytheon	1N 294	+1,0 V min. 5 mA	max 35 μ A
"	1N 295	+1,0 V min. 3,5 mA	max 35 μ A
"	1N 297	+1,0 V min. 15 mA	max 10 μ A
"	1N 298	+1,0 V min. 15 mA	max 20 μ A
"	1N 300	-1,0 V min. 8 mA	max 0,01 μ A
"	1N 300 A	-1,0 V min. 30 mA	max 0,01 μ A
"	1N 301	-1,0 V min. 5 mA	max 0,01 μ A
"	1N 301 A	-1,0 V min. 18 mA	max 0,01 μ A
"	1N 302	-1,0 V min. 1 mA	max 0,01 μ A
"	1N 302 A	-1,0 V min. 5 mA	max 0,01 μ A
"	1N 303	-1,0 V min. 3 mA	max 0,01 μ A
"	1N 303 A	-1,0 V min. 12 mA	max 0,01 μ A
"	1N 305	-0,8 V min. 100 mA	max 3 μ A
"	1N 306	-0,8 V min. 100 mA	max 2 μ A
"	1N 307	-1,0 V min. 100 mA	max 2 μ A
"	1N 308	-1,0 V min. 300 mA	max 80 μ A
"	1N 309	-1,0 V min. 100 mA	max 25 μ A
"	1N 310	-1,0 V min. 15 mA	max 8 μ A
"	1N 312	-1,0 V min. 30 mA	max 8 μ A
"	1N 313	+1,0 V min. 15 mA	max 5 μ A
"	1N 350	+1,0 V min. 20 mA	max 0,01 μ A
"	1N 351	+1,0 V min. 8 mA	max 0,01 μ A
"	1N 352	+1,0 V min. 5 mA	max 0,01 μ A
"	1N 353	+1,0 V min. 3 mA	max 0,01 μ A
"	1N 354	+1,0 V min. 1 mA	max 0,01 μ A

Halbleiterdioden Crystal diodes		Prüfdaten / Test operation / Verification	
		In Durchlafrichtung Direction of passage bei +25°C Up Id	In Sperrrichtg. Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C Isp
Fabrikat	Type		
Raytheon	1N 432	+1,0 V min. 10 mA	max 0,01 μ A
"	1N 432 A	+1,0 V min. 20 mA	max 0,01 μ A
"	1N 433	+1,0 V min. 3 mA	max 0,01 μ A
"	1N 433 A	+1,0 V min. 10 mA	max 0,01 μ A
"	1N 434	+1,0 V min. 2 mA	max 0,01 μ A
"	1N 434 A	+1,0 V min. 7 mA	max 0,01 μ A
Sylvania	1N 447	+1,0 V min. 25 mA	max 8 μ A
"	1N 448	+1,0 V min. 25 mA	max 8 μ A
"	1N 449	+1,0 V min. 50 mA	max 8 μ A
"	1N 450	+1,0 V min. 50 mA	max 8 μ A
"	1N 451	+1,0 V min. 50 mA	max 8 μ A
"	1N 452	+1,0 V min. 100 mA	max 8 μ A
"	1N 453	+1,0 V min. 100 mA	max 8 μ A
"	1N 454	+1,0 V min. 200 mA	max 8 μ A
"	1N 455	+1,0 V min. 300 mA	max 8 μ A
Hughes	1N 456	+1,0 V min. 40 mA	max 0,01 μ A
"	1N 457	+1,0 V min. 20 mA	max 0,01 μ A
"	1N 458	+1,0 V min. 7 mA	max 0,01 μ A
"	1N 459	+1,0 V min. 3 mA	max 0,01 μ A
"	1N 460	+1,0 V min. 5 mA	max 0,01 μ A
Raytheon	1N 460 A	+1,0 V min. 15 mA	max 0,01 μ A
Hughes	1N 461	+1,0 V min. 15 mA	max 0,1 μ A
"	1N 462	+1,0 V min. 5 mA	max 0,1 μ A
"	1N 463	+1,0 V min. 1 mA	max 0,1 μ A
"	1N 464	+1,0 V min. 3 mA	max 0,1 μ A
Clevite	1N 482	+1,1 V min. 100 mA	max 0,1 μ A
"	1N 482 A	+1,0 V min. 100 mA	max 0,01 μ A

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Durchlafrichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtung Max Peak Inverse Inverse dc grille bei +25° C Isp
Fabrikat	Type	Up V Id mA	Isp µA
Clevite	1N 483 A	+1.1 V	max 0.1 µA
	1N 483 A	+1.0 V	min. 100 mA
	1N 484 A	+1.1 V	max 0.1 µA
	1N 484 A	+1.0 V	min. 100 mA
	1N 485 A	+1.1 V	max 0.1 µA
	1N 485 A	+1.0 V	min. 100 mA
	1N 486 A	+1.1 V	max 0.01 µA
	1N 486 A	+1.0 V	min. 100 mA
	1N 487 A	+1.1 V	max 0.01 µA
	1N 487 A	+1.0 V	min. 100 mA
Amerika	1N 488 A	+1.1 V	max 0.01 µA
	1N 488 A	+1.0 V	min. 100 mA
Clevite	1N 643	+1.0 V	max 0.01 µA
	1N 658	+1.0 V	min. 100 mA
	1N 659	+1.0 V	max 1 µA
	1N 660	+1.0 V	min. 6 mA
	1N 661	+1.0 V	max 0.5 µA
	1N 662	+1.0 V	min. 6 mA
Clevite	1N 663	+1.0 V	max 0.5 µA
	1N 778	+1.0 V	min. 10 mA
1N 779	+1.0 V	min. 10 mA	

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification		
Crystal diodes		In Durchlafrichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtung Max Peak Inverse Inverse dc grille bei +25° C Isp	
Fabrikat	Type	Up V Id mA	Isp µA	
Amerika	1S 1	+1.0 V	max 3 µA	
	1T 1	+1.0 V	min. 1.5 mA	
	1U 1	+1.0 V	max 3 µA	
	1V 1	+1.0 V	max 1 µA	
	1Y 1	+1.0 V	max 5 µA	
	1Y 1	+1.0 V	max 10 µA	
	Tekade	1,5/20	+1.0 V	max 5 µA
		2 S 1	+1.0 V	max 3 µA
		2 T 1	+1.0 V	max 3 µA
		2 U 1	+1.0 V	max 1 µA
Amerika	2 V 1	+1.0 V	max 5 µA	
	2 V 1	+1.0 V	max 5 µA	
STC	2X101 G	+1.0 V	min. 1 mA	
	2X102 G	+1.0 V	max 10 µA	
	2X103 G	+1.0 V	min. 2 mA	
	2X104 G	+1.0 V	max 10 µA	
	2X105 G	+1.0 V	min. 4 mA	
	2X106 G	+1.0 V	max 70 µA	
	2X106 G	+1.0 V	min. 1 mA	
	2X106 G	+1.0 V	max 35 µA	
	2,5/9	+1.0 V	min. 3 mA	
	2,5/15	+1.0 V	max 80 µA	
Tekade	4/10	+1.0 V	min. 2.5 mA	
	4/10	+1.0 V	max 5 µA	
	4/10	+1.0 V	min. 4 mA	
	4/12	+1.0 V	max 6 µA	
	4/12	+1.0 V	min. 4 mA	
	5/2	+1.0 V	max 3 µA	
	5/4	+1.0 V	min. 5 mA	
	5/6	+1.0 V	max 40 µA	
	5/6	+1.0 V	min. 5 mA	
	5/61	+1.0 V	max 10 µA	
Ehrlite & Co.	0100	+1.2 V	min. 50 mA	
	0101	+1.2 V	min. 50 mA	
	0101	+1.2 V	min. 50 mA	
	0102	+1.2 V	max 0.1 µA	

1N

1

Halbleiterdioden		Halbleiterdioden					
Crystal diodes		Crystal diodes					
Fabrikat	Type	Prüfdaten / Test operation - Verification		Prüfdaten / Test operation - Verification			
		U _D	I _D	In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25° C	I _{sp}	In Durchlaßrichtung Direction of passage Direction de passage bei +25° C	I _D
Amerika	400 A	-	1,0 V min. 5 mA	max 45 µA	+	1,0 V min. 5 mA	max 40 µA
"	400 B	-	1,0 V min. 3 mA	max 50 µA	+	1,0 V min. 6 mA	max 35 µA
"	400 C	-	1,0 V min. 3 mA	max 30 µA	+	1,0 V min. 3,5 mA	max 10 µA
"	400 D	-	1,0 V min. 3 mA	max 60 µA	+	1,0 V min. 3 mA	max 25 µA
"	600	-	1,0 V min. 3 mA	max 5 µA	+	0,5 V min. 3 mA	max 90 µA
"	600 C	-	1,0 V min. 3 mA	max 0,01 µA	+	1,0 V min. 1 mA	max 15 µA
"	601	-	1,0 V min. 3 mA	max 0,01 µA	+	1,2 V min. 13 mA	max 20 µA
"	601 C	-	1,0 V min. 3 mA	max 0,01 µA	+	1,0 V min. 10 mA	max 45 µA
"	604 C	-	1,0 V min. 60 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	606 C	-	1,0 V min. 35 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	608 C	-	1,0 V min. 25 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	610 C	-	1,0 V min. 12 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	612 C	-	1,0 V min. 7 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	614 C	-	1,0 V min. 5 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	616 C	-	1,0 V min. 3 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	618 C	-	1,0 V min. 1,5 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	620 C	-	1,0 V min. 0,9 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	622 C	-	1,0 V min. 1,8 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	624 C	-	1,2 V min. 1 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	626 C	-	1,2 V min. 0,6 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	628 C	-	1,2 V min. 0,3 mA	max 0,1 µA	-	-	-
"	650 CO-C7	-	1,0 V min. 125 mA	max 0,4 µA	-	-	-
"	651 CO-C9	-	1,0 V min. 100 mA	max 0,4 µA	-	-	-
"	652 CO-C9	-	1,0 V min. 75 mA	max 0,4 µA	-	-	-
"	643 CO-C5	-	1,0 V min. 80 mA	max 0,4 µA	-	-	-

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25°C U _D	In Sperrrichtg. Max Peak Inverse Inverse de crite bei +25°C I _{SP}
Fabrikat	Type		
Proton	BH BH 30 BH 60 BH 80	+1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 2 mA max 3 mA min. 3 mA max 3 mA
"	BK 6 BK 6/s BK 60	+1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 4 mA max 4 mA min. 3 mA max 3 mA
"	BH BH 6 BN 6/s BN 15	+1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 3 mA max 4 mA min. 4 mA max 4 mA
"	BS BS 60	+1,0 V +1,0 V	min. 2 mA max 3 mA

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei -25°C U _D	In Sperrrichtg. Max Peak Inverse Inverse de crite bei +25°C I _{SP}
Fabrikat	Type		
Ampereux	C 60 C 67 C 68 C 89 C 95 C 99 C 116 C 117	+1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 4 mA max 4 mA min. 3 mA max 3,5 mA min. 10 mA max 10 mA min. 5 mA max 10 mA
BTH	CG 1 C CG 1 E CG 4 C CG 4 E	+1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 4 mA max 4 mA min. 3 mA max 3 mA
"	CG 5 C CG 5 E CG 5 M CG 6 C CG 6 E CG 6 M CG 7 C CG 8 C	+1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 3 mA max 3 mA min. 3 mA max 2 mA min. 2 mA max 2 mA min. 2 mA max 2 mA
"	CG 10 E CG 10 M CG 12 E	+1,0 V +1,0 V +1,0 V	min. 2 mA max 2 mA min. 3 mA max 3 mA

Halbleitertypen		Prüfdaten / Test operation / Verification		
Crystal diodes		In Durchlafrichtung Direction of passage bei +25°C		In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C
Fabrikat	Type	U _p	I _p	I _{sp}
Raytheon	CK 705	+1,0 V	min. 5 mA	max 40 µA
"	CK 705 P	+1,0 V	min. 5 mA	max 40 µA
"	CK 706	+1,0 V	max 35 µA	max 35 µA
"	CK 706 P	+1,0 V	max 35 µA	max 35 µA
"	CK 707	+1,0 V	min. 3,5 mA	max 10 µA
"	CK 707 P	+1,0 V	min. 3,5 mA	max 10 µA
"	CK 708	+1,0 V	min. 3 mA	max 25 µA
"	CK 708 P	+1,0 V	min. 3 mA	max 25 µA
"	CK 710	+0,5 V	min. 3 mA	max 90 µA
"	CK 712	+1,2 V	min. 1 mA	max 15 µA
"	CK 713	+1,2 V	min. 13 mA	max 20 µA
"	CK 713 P	+1,0 V	min. 13 mA	max 20 µA
"	CK 715	+1,0 V	min. 10 mA	max 45 µA
"	CK 715 P	+1,0 V	min. 10 mA	max 45 µA
"	CK 735	+1,0 V	min. 10 mA	max 0,4 µA
"	CK 736	+1,0 V	min. 2 mA	max 0,4 µA
"	CK 737	+0,5 V	min. 0,5 mA	max 0,4 µA
"	CK 738	+1,0 V	min. 1 mA	max 0,7 µA
"	CK 739	+0,35 V	min. 10 mA	max 1 µA
"	CK 740	+0,75 V	min. 100 mA	max 15 µA

Halbleitertypen		Prüfdaten / Test operation / Verification		
Crystal diodes		In Durchlafrichtung Direction of passage bei +25°C		In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25°C
Fabrikat	Type	U _p	I _p	I _{sp}
Raytheon	CK 860	+1,0 V	min. 0,5 mA	max 0,4 µA
"	CK 861	+1,0 V	min. 0,5 mA	max 0,4 µA
"	CK 863	+1,0 V	min. 0,5 mA	max 0,4 µA
Clevita	CTP 2310	+1,2 V	min. 4 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2312	+1,2 V	min. 4 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2313	+1,2 V	min. 4 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2314	+1,2 V	min. 4 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2315	+1,2 V	min. 4 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2316	+1,2 V	min. 4 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2317	+1,2 V	min. 4 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2325	+1,2 V	min. 24 mA	max 0,1 µA
"	CTP 2359	+1,2 V	min. 80 mA	max 0,1 µA
BTH	CV 425	+1,0 V	min. 4 mA	max 50 µA

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification		Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification		
Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction de passage bei +25° C		Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction de passage bei +25° C		
Fabrikat	Type	U _D	I _D	Fabrikat	Type	U _D	I _D	
		In Sperrrichtung Max Peak Inverse Inverse de crête bei +25° C I _{sp}				In Sperrrichtung Max Peak Inverse Inverse de crête bei +25° C I _{sp}		
Siemens	GD 5 E	+1,0 V	8 mA	Tekade	GSD 1,5/20	+1,0 V	min 1,5 mA	max 5 µA
"	GD 6 E	+1,0 V	3 mA	"	GSD 2,5/9	+1,0 V	min 2,5 mA	max 5 µA
"	GD 7 E/1	+1,0 V	2 mA	"	GSD 2,5/15	+1,0 V	min 2,5 mA	max 5 µA
"	GD 7 E/2	+1,0 V	2 mA	"	GSD 4/10	+1,0 V	min 4 mA	max 6 µA
"	GD 7 E/3	+1,0 V	2 mA	"	GSD 4/12	+1,0 V	min 4 mA	max 3 µA
"	GD 7 E/4	+1,0 V	2 mA	"	GSD 5/2	+1,0 V	min 5 mA	max 40 µA
"	GD 7 E/5	+1,0 V	2 mA	"	GSD 5/4	+1,0 V	min 5 mA	max 40 µA
STC	GD 8 E	+1,0 V	3 mA	"	GSD 5/6	+1,0 V	min 5 mA	max 10 µA
Siemens	GD 9 E	+1,0 V	20 mA	"	GSD 5/40	+1,0 V	min 5 mA	max 3 µA
STC	GD 10	+1,0 V	6 mA	"	GSD 5/61	+1,0 V	min 15 mA	max 60 µA
"	GD 11 E	+1,0 V	5 mA	"	GSD 15/4	+1,0 V	min 15 mA	max 70 µA
Siemens	GD 12 E	+1,0 V	10 mA	Howaldt	GSD 50/2	+1,0 V	min 50 mA	max 70 µA
STC	GD 12 E	+1,0 V	5 mA	"	GV 1	+0,35 V	min 100 mA	max 40 µA
Siemens	GD 71 E	+1,0 V	2 mA	"	GV 2	+0,35 V	min 100 mA	max 30 µA
"				"	GV 3	+0,35 V	min 100 mA	max 25 µA
GEC, AW	GEX 34	+1,0 V	1 mA	Rost	GW 20	+1,0 V	min 5 mA	max 50 µA
"	GEX 44/1	+1,0 V	1 mA	"	GW 40	+1,0 V	min 3 mA	max 46 µA
"	GEX 45/1	+1,0 V	4 mA	"	GW 60	+1,0 V	min 3 mA	max 10 µA
GEC	GEX 54	+1,0 V	4 mA	"	GW 80	+1,0 V	min 3 mA	max 35 µA
"	GEX 54/3	+1,0 V	3 mA	"	GW 100	+1,0 V	min 1 mA	max 22 µA
"	GEX 54/4	+1,0 V	3 mA	"	GW 101	+1,0 V	min 5 mA	max 45 µA
"	GEX 54/5	+1,0 V	3 mA	"	GW 102	+1,0 V	min 5 mA	max 52 µA
GEC, AW	GEX 55/1	+1,0 V	1 mA	"	GW 103	+1,0 V	min 5 mA	max 32 µA
GEC	GEX 56	+1,0 V	1 mA	"	GW 120	+1,0 V	min 1 mA	max 28 µA
GEC, AW	GEX 65	+0,3 V	5 mA	"	GW 201	+1,0 V	min 5 mA	max 70 µA
"	GEX 66	+1,0 V	6 mA	"	GW 203	+1,0 V	min 5 mA	max 14 µA
				"	GW 402	+1,0 V	min 1,5 mA	max 52 µA
				"	GW 603	+1,0 V	min 3 mA	max 46 µA

Halbleitertypen		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes	Type	In Durchlaßrichtung Direction de passage bei +25°C	In Sperrrichtung Max. Peak Inverse Inverse de crête bei +25°C
Fabrikat	Type	U _D / I _D	I _{sp}
Hughes	HD 2013	+1,0 V / min 50 mA	max 60 µA
"	HD 2014	+1,0 V / min 50 mA	max 85 µA
"	HD 2051	+1,0 V / min 4 mA	max 7 µA
"	HD 2052	+1,0 V / min 5 mA	max 20 µA
"	HD 2053	+1,0 V / min 3 mA	max 25 µA
"	HD 2054	+1,0 V / min 4 mA	max 4 µA
"	HD 2055	+1,0 V / min 10 mA	max 5 µA
"	HD 2056	+1,0 V / min 20 mA	max 5 µA
"	HD 2057	+1,0 V / min 3,5 mA	max 7 µA
"	HD 2058	+1,0 V / min 10 mA	max 6 µA
"	HD 2059	+1,0 V / min 20 mA	max 6 µA
"	HD 2060	+1,0 V / min 5 mA	max 10 µA
"	HD 2061	+1,0 V / min 10 mA	max 10 µA
"	HD 2062	+1,0 V / min 20 mA	max 10 µA
"	HD 2063	+1,0 V / min 5 mA	max 40 µA
"	HD 2064	+1,0 V / min 10 mA	max 35 µA
"	HD 2065	+1,0 V / min 20 mA	max 35 µA
"	HD 2066	+1,0 V / min 5 mA	max 35 µA
"	HD 2067	+1,0 V / min 3 mA	max 5 µA
"	HD 2068	+1,0 V / min 3 mA	max 6 µA
"	HD 2070	+1,0 V / min 5 mA	max 35 µA
"	HD 2071	+1,0 V / min 3 mA	max 5 µA
"	HD 2072	+1,0 V / min 3 mA	max 6 µA
"	HD 2077	+1,0 V / min 5 mA	max 25 µA
"	HD 2078	+1,0 V / min 5 mA	max 25 µA
"	HD 2150	+1,0 V / min 100 mA	max 7 µA
"	HD 2151	+1,0 V / min 50 mA	max 7 µA
"	HD 2152	+1,0 V / min 100 mA	max 40 µA

Halbleitertypen		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes	Type	In Durchlaßrichtung Direction de passage bei +25°C	In Sperrrichtung Max. Peak Inverse Inverse de crête bei +25°C
Fabrikat	Type	U _D / I _D	I _{sp}
Hughes	HD 2154	+1,0 V / min 150 mA	max 10 µA
"	HD 2155	+1,0 V / min 150 mA	max 40 µA
"	HD 2157	+1,0 V / min 200 mA	max 10 µA
"	HD 2158	+1,0 V / min 200 mA	max 7 µA
"	HD 2159	+1,0 V / min 200 mA	max 40 µA
"	HD 2160	+1,0 V / min 200 mA	max 7 µA
"	HD 2161	+1,0 V / min 200 mA	max 25 µA
"	HD 2162	+1,0 V / min 100 mA	max 40 µA
"	HD 2163	+1,0 V / min 100 mA	max 7 µA
"	HD 2165	+1,0 V / min 100 mA	max 25 µA
"	HD 2166	+1,0 V / min 50 mA	max 10 µA
"	HD 2167	+1,0 V / min 50 mA	max 7 µA
"	HD 2168	+1,0 V / min 50 mA	max 10 µA
"	HD 2169	+1,0 V / min 50 mA	max 40 µA
"	HD 2170	+1,0 V / min 50 mA	max 25 µA
"	HD 2171	+1,0 V / min 200 mA	max 40 µA
"	HD 2172	+1,0 V / min 200 mA	max 40 µA
"	HD 2173	+1,0 V / min 100 mA	max 7 µA
"	HD 2174	+1,0 V / min 100 mA	max 10 µA
"	HD 2175	+1,0 V / min 100 mA	max 40 µA
"	HD 6001	+1,0 V / min 15 mA	max 0,1 µA
"	HD 6002	+1,0 V / min 5 mA	max 0,01 µA
"	HD 6003	+1,0 V / min 1 mA	max 0,1 µA
"	HD 6005	+1,0 V / min 40 mA	max 0,01 µA
"	HD 6006	+1,0 V / min 20 mA	max 0,01 µA
"	HD 6007	+1,0 V / min 7 mA	max 0,01 µA
"	HD 6008	+1,0 V / min 3 mA	max 0,01 µA
"	HD 6009	+1,0 V / min 3 mA	max 0,01 µA

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Durchschichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtg. Max Peak inverse Inverse de câble bei +25° C
Fabrikat	Type	U ₀ I _D	I _{sp}
Hughes	HD 6132	+1,0 V min 100 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6133	+1,0 V min 100 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6134	+1,0 V min 100 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6135	+1,0 V min 100 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6136	+1,0 V min 100 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6764	+1,0 V min 200 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6766	+1,0 V min 200 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6768	+1,0 V min 200 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6771	+1,0 V min 200 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6773	+1,0 V min 200 mA	max 0,01 μ A
"	HD 6775	+1,0 V min 200 mA	max 0,01 μ A
Howaldt	HO 1	+0,35 V min 1 mA	max 40 μ A
"	HO 2	+0,35 V min 1 mA	max 52 μ A
"	HO 3	+0,35 V min 2 mA	max 46 μ A

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes		In Durchschichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtg. Max Peak inverse Inverse de câble bei +25° C
Fabrikat	Type	U ₀ I _D	I _{sp}
Tekade	K 1,5/20	+1,0 V min. 1,5 mA	max 5 μ A
"	K 2,5/9	+1,0 V min. 2,5 mA	max 5 μ A
"	K 2,5/15	+1,0 V min. 2,5 mA	max 5 μ A
"	K 4/10	+1,0 V min. 4 mA	max 6 μ A
"	K 4/12	+1,0 V min. 4 mA	max 3 μ A
"	K 5/2	+1,0 V min. 5 mA	max 40 μ A
"	K 5/4	+1,0 V min. 5 mA	max 40 μ A
"	K 5/6	+1,0 V min. 5 mA	max 10 μ A
"	K 5/61	+1,0 V min. 5 mA	max 3 μ A

Halbleitertioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes	Type	In Durchlafrichtung Direction de passage bei +25° C	In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25° C
Fabrikat	Type	U _D	I _{sp}
Intermetall			
-	M 34 a	+1,0 V min. 5 mA	max 40 µA
-	M 38 a	+1,0 V min. 4 mA	max 25 µA
-	M 51	+1,0 V min. 2,5 mA	max 50 µA
-	M 54 a	+1,0 V min. 5 mA	max 10 µA
-	M 55	+1,0 V min. 8 mA	max 15 µA
-	M 56	+1,0 V min. 15 mA	max 40 µA
-	M 60		max 50 µA
-	M 69	+1,0 V min. 5 mA	max 48 µA
-	M 70	+1,0 V min. 3 mA	max 40 µA
-	M 81	+1,0 V min. 3 mA	max 7 µA
-	M 95	+1,0 V min. 10 mA	max 46 µA
-	M 550	+1,0 V min. 5 mA	max 46 µA
-	M 550 a	+1,0 V min. 5 mA	max 40 µA
-	M 550 b	+1,0 V min. 5 mA	max 10 µA
-	M 820	+1,0 V min. 8 mA	max 60 µA
-	M 1230	+1,0 V min. 12 mA	max 54 µA
-	M 2150	+1,0 V min. 2 mA	max 26 µA
-	M 3100	+1,0 V min. 3 mA	max 35 µA
-	M 6100	+1,0 V min. 6 mA	max 35 µA
WBN	MD 100	+0,3 V min. 0,2 mA	max 50 µA
-	MD 120	+0,3 V min. 1 mA	max 60 µA

Halbleitertioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal diodes	Type	In Durchlafrichtung Direction de passage bei +25° C	In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25° C
Fabrikat	Type	U _D	I _{sp}

Alle mit „O“ (wie Otro) beginnenden Typen siehe unter „O“
(= Null) auf den Seiten 32—35.

„O“ see on page 32—35

„O“ regardée page 32—35

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification		
Crystal diodes	In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25° C Isp		
Fabrikat	U _p	I _p		
Pazific- Se-ni-Conductors	PS 200	+1.0 V	min. 20 mA	max 7 µA
	PS 201	+1.0 V	min. 150 mA	max 10 µA
	PS 206	+1.0 V	min. 75 mA	max 10 µA
	PS 208	+1.2 V	min. 20 mA	max 10 µA
	PS 500	+1.0 V	min. 3 mA	max 0.01 µA
PS 501	+1.0 V	min. 10 mA	max 0.01 µA	
PS 502	+1.0 V	min. 30 mA	max 0.01 µA	
			min. 60 mA	max 0.01 µA

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification		
Crystal diodes	In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei +25° C Isp		
Fabrikat	U _p	I _p		
Siemens	RD 120	+1.0 V	min. 5 mA	max 25 µA
	RD 120 a	+1.0 V	min. 10 mA	max 30 µA
	RD 121	+1.0 V	min. 2 mA	max 10 µA
	RD 140	+1.0 V	min. 5 mA	max 10 µA
	RD 140 a	+1.0 V	min. 10 mA	max 15 µA
	RD 141	+1.0 V	min. 2 mA	max 9 µA
	RD 160	+1.0 V	min. 2 mA	max 8 µA
	RD 6/2/2	+1.0 V	min. 2 mA	max 40 µA
	RD 6/2/10	+1.0 V	min. 2 mA	max 40 µA
	RD 6/2/40	+1.0 V	min. 2 mA	max 52 µA
	RD 6/4/2	+1.0 V	min. 5 mA	max 52 µA
	RD 6/4/10	+1.0 V	min. 5 mA	max 50 µA
	RD 6/4/40	+1.0 V	min. 2 mA	max 50 µA
	RD 6/8/2	+1.0 V	min. 40 µA	max 40 µA
RD 6/8/10	+1.0 V	min. 40 µA	max 40 µA	
RD 31	+1.0 V	min. 2 mA	max 40 µA	
RD 32	+1.0 V	min. 2 mA	max 52 µA	
RD 34	+1.0 V	min. 5 mA	max 20 µA	
RD 43	+1.0 V	min. 2 mA	max 40 µA	
RD 44	+1.0 V	min. 3 mA	max 5 µA	
RL 101	+1.0 V	min. 3 mA	max 45 µA	
RL 102	+1.0 V	min. 3 mA	max 35 µA	
RL 103	+1.0 V	min. 2 mA	max 15 µA	
RL 104	+1.0 V	min. 3 mA	max 46 µA	
RL 105	+1.0 V	min. 2 mA	max 35 µA	
RL 106	+1.0 V	min. 2 mA	max 18 µA	
RL 107	+1.0 V	min. 2 mA	max 9 µA	

Halbleitertypen Crystal diodes		Prüfdaten / Test operation / Verification			In Sperrrichtung Max. Peak inverse Inverse de crête bei +25°C	
Fabrikat	Type	UD	ID	IP	Is	Isp
Siemens	RL 108	+1,0 V	min.	5 mA	max	9 μ A
"	RL 109	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 110	+1,0 V	min.	3 mA	max	46 μ A
"	RL 111	+1,0 V	min.	2 mA	max	38 μ A
"	RL 112	+1,0 V	min.	2 mA	max	18 μ A
"	RL 113	+1,0 V	min.	2 mA	max	9 μ A
"	RL 114	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 115	+1,0 V	min.	3 mA	max	48 μ A
"	RL 116	+1,0 V	min.	2 mA	max	38 μ A
"	RL 117	+1,0 V	min.	2 mA	max	20 μ A
"	RL 118	+1,0 V	min.	2 mA	max	9 μ A
"	RL 119	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 120	+1,0 V	min.	5 mA	max	7 μ A
"	RL 121	+1,0 V	min.	2 mA	max	38 μ A
"	RL 122	+1,0 V	min.	2 mA	max	10 μ A
"	RL 123	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 131	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 132	+1,0 V	min.	2 mA	max	10 μ A
"	RL 133	+1,0 V	min.	3 mA	max	49 μ A
"	RL 134	+1,0 V	min.	2 mA	max	40 μ A
"	RL 141	+1,0 V	min.	3 mA	max	60 μ A
"	RL 143	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 145	+1,0 V	min.	2 mA	max	52 μ A
"	RL 201	+1,0 V	min.	3 mA	max	46 μ A
"	RL 202	+1,0 V	min.	3 mA	max	36 μ A
"	RL 203	+1,0 V	min.	2 mA	max	15 μ A
"	RL 204	+1,0 V	min.	3 mA	max	46 μ A

Halbleitertypen Crystal diodes		Prüfdaten / Test operation / Verification			In Sperrrichtung Max. Peak inverse Inverse de crête bei +25°C	
Fabrikat	Type	UD	ID	IP	Is	Isp
Siemens	RL 205	+1,0 V	min.	2 mA	max	36 μ A
"	RL 206	+1,0 V	min.	2 mA	max	20 μ A
"	RL 207	+1,0 V	min.	2 mA	max	10 μ A
"	RL 208	+1,0 V	min.	5 mA	max	10 μ A
"	RL 209	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 210	+1,0 V	min.	3 mA	max	46 μ A
"	RL 211	+1,0 V	min.	2 mA	max	36 μ A
"	RL 212	+1,0 V	min.	2 mA	max	20 μ A
"	RL 213	+1,0 V	min.	2 mA	max	10 μ A
"	RL 214	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 215	+1,0 V	min.	3 mA	max	46 μ A
"	RL 216	+1,0 V	min.	2 mA	max	36 μ A
"	RL 217	+1,0 V	min.	2 mA	max	20 μ A
"	RL 218	+1,0 V	min.	2 mA	max	10 μ A
"	RL 219	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 220	+1,0 V	min.	5 mA	max	7 μ A
"	RL 221	+1,0 V	min.	2 mA	max	36 μ A
"	RL 222	+1,0 V	min.	2 mA	max	10 μ A
"	RL 223	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 231	+1,0 V	min.	2 mA	max	7 μ A
"	RL 232	+1,0 V	min.	2 mA	max	10 μ A
"	RL 233	+1,0 V	min.	3 mA	max	7 μ A
"	RL 234	+1,0 V	min.	2 mA	max	40 μ A
"	RL 246	+1,0 V	min.	2 mA	max	52 μ A
"	RL 247	+1,0 V	min.	1 mA	max	40 μ A

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification			
Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtg. Max Peak Inverse Inverse de crête bei +25° C		
Fabrikat	Type	U _D	I _D		
Intermetall	SZ 21	+1,0 V	1 mA	max 0,1 μ A	
	SZ 22	+1,0 V	1 mA	max 0,01 μ A	
	SZ 23	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 24	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 32	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 33	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 34	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 35	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	Siemens	SD 8	+10, V	min. 6,5 mA	max 0,1 μ A
		SD 10	+10, V	min. 3,5 mA	max 0,1 μ A
SD 12		+10, V	min. 2 mA	max 0,1 μ A	
SD 14		+10, V	min.	max 0,1 μ A	
SD 16		+1,0 V	min. 0,5 mA	max 0,1 μ A	
SIC 5 A		+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
SZ 6		+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
SZ 7		+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
SZ 8		+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
SZ 9		+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
Rost	SZ 10	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 11	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 12	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 13	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 14	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 15	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 16	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 17	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 18	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
	SZ 19	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A	
SZ 20	+1,0 V	min.	max 0,1 μ A		

← sind Zenerdioden →

Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Verification			
Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25° C	In Sperrrichtg. Max Peak Inverse Inverse de crête bei +25° C		
Fabrikat	Type	U _D	I _D		
Transition	T1	+1,0 V	min 20 mA	max 55 μ A	
	T2	+1,0 V	min 40 mA	max 30 μ A	
	T3	+1,0 V	min 20 mA	max 7 μ A	
	T4	+1,0 V	min 5 mA	max 7 μ A	
	T5	+1,0 V	min. 40 mA	max 7 μ A	
	T6 G	+1,0 V	min. 5 mA	max 5 μ A	
	T7 G	+1,0 V	min. 5 mA	max 5 μ A	
	T9 G	+0,35 V	min. 10 mA	max 1 μ A	
	Siemens	T11 G	+0,35 V	min. 10 mA	max 1 μ A
		T12 G	+0,35 V	min. 10 mA	max 1 μ A
T13 G		+0,75 V	min. 100 mA	max 15 μ A	
T14 G		+0,75 V	min. 100 mA	max 15 μ A	
T16 G		+0,35 V	min 10 mA	max 1 μ A	
T17 G		+1,0 V	min. 5 mA	max 5 μ A	
T18 G		+0,35 V	min. 10 mA	max 1 μ A	
Siemens		T20 G	+0,35 V	min. 10 mA	max 1 μ A
		T21 G	+0,75 V	min. 100 mA	max 15 μ A
		T22 G	+0,75 V	min. 100 mA	max 15 μ A
	T23 G	+0,35 V	min. 10 mA	max 1 μ A	
	T24 G	+0,35 V	min. 10 mA	max 1 μ A	
	T25 G	+0,75 V	min. 100 mA	max 15 μ A	
	TP	TP 34 A	+1,0 V	min. 5 mA	max 40 μ A
		TP 38 A	+1,0 V	min. 4 mA	max 25 μ A
		TP 39	+1,0 V	min. 1,5 mA	max 20 μ A
		TP 52	+1,0 V	min. 4 mA	max 15 μ A
TP 55		+1,0 V	min. 3 mA	max 25 μ A	
TP 55 A		+1,0 V	min. 4 mA	max 15 μ A	
TP 63	+1,0 V	min. 4 mA	max 7 μ A		

Halbleiterdioden		Halbleiterdioden		Prüfdaten / Test operation / Vérification		Prüfdaten / Test operation / Vérification	
Crystal diodes		Crystal diodes		In Durchlaßrichtung Direction of passage à $+25^{\circ}\text{C}$.		In Sperrrichtung Max Peak inverse Inverse de crête bei $+25^{\circ}\text{C}$	
Fabrikat	Type	Fabrikat	Type	U _D	I _D	U _D	I _D
-	Z 5	Amerika	WE 400 A	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 5 mA
-	Z 6	-	WE 400 B	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 3 mA
-	Z 7	-	WE 400 C	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 3 mA
-	Z 8	-	WE 400 D	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 3 mA
-	Z 10	-	WG 1-1	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 60 mA
-		-	WG 1-2	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 30 mA
-		-	WG 1-3	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 10 mA
-		-	WG 1-4	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 60 mA
-		-	WG 2-1	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 50 mA
-		-	WG 2-2	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 70 mA
-		-	WG 2-3	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 95 mA
-		-	WG 2-4	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 85 mA
-		-	WG 4 A	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 2 mA
-		-	WG 4 B	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 5 mA
-		-	WG 5 A	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 1 mA
-		-	WG 5 B	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 5 mA
-		-	WG 6 A	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 1 mA
-		-	WG 7 A	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 1 mA
-		-	WG 7 B	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 5 mA
-		-	WG 7 C	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 5 mA
-		-	WG 7 D	+1,0 V	min. 20 mA	+1,0 V	min. 1 mA

Nachtrag

Halbleiterioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal specs		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25° C	
Fabrikat	Type	UD	ID

Nachtrag

Halbleiterioden		Prüfdaten / Test operation / Verification	
Crystal specs		In Durchlaßrichtung Direction of passage bei +25° C	
Fabrikat	Type	UD	ID

Max FUNKE KG.

Spezialfabrik für Röhrenmeßgeräte

5488 Adenau

